

## Βιογραφικό Σημείωμα

<b>Όνομα</b>	<b>Γεώργιος Δημητρακόπουλος</b>
Θέση	Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ
Σπουδές	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ (1999)</li> <li>• M.Sc. (Eng.) with distinction in Advanced Engineering Materials, Department of Materials Science &amp; Engineering, University of Liverpool, UK (1990)</li> <li>• Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ (1989)</li> </ul>
Επιστημονική Εμπειρία	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Καθηγητής (2019-)</li> <li>• Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ (2014-2019)</li> <li>• Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ (2007-2014)</li> <li>• Μεταδιδάκτωρ Ερευνητής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ (1999 -2007)</li> <li>• Μέλος του Institute of Physics (MInstPhys) - Chartered Physicist (CPhys) - Μέλος του Electron Microscopy and Analysis Group</li> <li>• Μέλος της European Microscopy Society (EMS)</li> <li>• Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας</li> <li>• Μέλος της European Materials Research Society (EMRS)</li> <li>• Μέλος της Ελληνικής Εταιρεία Επιστήμης και Τεχνολογίας της Συμπυκνωμένης Ύλης (ΕΕΤΣΥ)</li> </ul>
Ερευνητικό Έργο	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt;110 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές</li> <li>• &gt;220 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και σχολείων</li> <li>• 4 κεφάλαια σε βιβλία</li> <li>• Επιβλέπων 8 ερευνητικών έργων και συμμετέχων σε 27 ερευνητικά έργα.</li> <li>• 12 συμμετοχές στη διοργάνωση συνεδρίων</li> <li>• Κριτής σε 25 διεθνή επιστημονικά περιοδικά</li> <li>• Επίβλεψη 14 διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών</li> <li>• Επίβλεψη 4 διδακτορικών διατριβών και μέλος σε 3 τριμελείς επιτροπές διδακτορικών</li> <li>• 17 προσκεκλημένες ομιλίες</li> </ul> <p>Ερευνητικά θέματα: Φυσική Υλικών. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και Δομικές Ιδιότητες Υλικών. Διεπιφάνειες, Δομικές Ατέλειες Στερεών, Νανοελαστικότητα, Ετεροδομές, Νανοδομές.</p>
Πρόσφατες Επιστημονικές Δημοσιεύσεις	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Structural anisotropic properties of <i>a</i>-plane GaN epilayers grown on <i>r</i>-plane sapphire</b> / <i>J. Appl. Physics</i> <b>115</b>, 213506 (2014). / A. Lotsari, Th. Kehagias, G. Tsiakatouras, K. Tsagaraki, M. Katsikini, J. Arvanitidis, D. Christofilos, S. Ves, Ph. Komninou, A. Georgakilas, and <u>G. P. Dimitrakopoulos</u></li> <li>2. <b>Observation of Surface Dirac Cone in High-Quality Ultrathin Epitaxial Bi<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> Topological Insulator on AlN(0001) Dielectric</b> / <i>ACS Nano</i> <b>8</b>, 6614 (2014). / P. Tsipas, E. Xenogiannopoulou, S.</li> </ol>

Kassavetis, D. Tsoutsou, E. Golias, C. Bazioti, G. P. Dimitrakopoulos, et al.

3. **High quality large area MoSe<sub>2</sub> and MoSe<sub>2</sub>/Bi<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> heterostructures on AlN(0001)/Si(111) substrates by molecular beam epitaxy** / *Nanoscale* **7**, 7896 (2015). / E. Xenogiannopoulou, P. Tsipas, K. E. Aretouli, D. Tsoutsou, S. A. Giamini, C. Bazioti, G. Dimitrakopoulos, et al.
4. **Sub-surface laser nanostructuring in stratified metal/dielectric media: a versatile platform towards flexible, durable and large-scale plasmonic writing** / *Nanotechnology* **26**, 155301 (2015). / A. Siozios, N. Kalfagiannis, D. V. Bellas, C. Bazioti, G. P. Dimitrakopoulos, et al.
5. **Defects, strain relaxation, and compositional grading in high indium content InGaN epilayers grown by molecular beam epitaxy** / *J. Appl. Phys.* **118**, 155301 (2015). / C. Bazioti, E. Papadomanolaki, Th. Kehagias, T. Walther, J. Smalc-Koziorowska, E. Pavlidou, Ph. Komninou, Th. Karakostas, E. Iliopoulos, and G. P. Dimitrakopoulos
6. **Structure, strain, and composition profiling of InAs/GaAs(211)B quantum dot superlattices** / *J. Appl. Phys.* **119**, 034304 (2016). / N. Florini, G. P. Dimitrakopoulos, et al.
7. **Stacking fault domains as sources of a-type threading dislocations in III-nitride heterostructures (Highlight paper)** / *Appl. Phys. Lett.* **108**, 051901 (2016). / J. Smalc-Koziorowska, C. Bazioti, M. Albrecht, and G.P. Dimitrakopoulos\*
8. **Study of fully epitaxial Fe/Pt bilayers for spin pumping by ferromagnetic resonance spectroscopy** / *Phys. Rev. B – Cond. Matter and Mater. Phys.* **93**, 134405 (2016). / A. Conca, S. Keller, L. Mihalceanu, Th. Kehagias, G.P. Dimitrakopoulos, et al.
9. **Enhanced Stark Tuning of Single InAs (211)B Quantum Dots due to Nonlinear Piezoelectric Effect in Zincblende Nanostructures** / *Phys. Rev. Applied* **6**, 014004 (2016). / S. Germanis, C. Katsidis, S. Tsintzos, A. Stavrinidis, G. Konstantinidis, N. Florini, J. Kioseoglou, G.P. Dimitrakopoulos, et al.
10. **Photoluminescence enhancement of ZnO via coupling with surface plasmons on Al thin films** / *J. Appl. Phys.* **121**, 103104 (2017). / S. Dellis, N. Kalfagiannis, S. Kassavetis, C. Bazioti, G.P. Dimitrakopoulos et al.
11. **Exploring the Leidenfrost Effect for the Deposition of High-Quality In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Layers via Spray Pyrolysis at Low Temperatures and Their Application in High Electron Mobility Transistors** / *Adv. Functional Materials* 1606407 (2017). / I. Isakov, H. Faber, M. Grell, G. Wyatt-Moon, N. Pliatsikas, Th. Kehagias, G. P. Dimitrakopoulos, et al.
12. **Heterojunction oxide thin-film transistors with unprecedented electron mobility grown from solution** / *Science Advances* **3**, e1602640 (2017). / H. Faber, S. Das, Y.-H. Lin, N. Pliatsikas, K. Zhao, Th. Kehagias, G. Dimitrakopoulos, et al.
13. **Investigation of magnetic coupling in FePt/spacer/FePt trilayers** / *J. Phys. D: Appl. Phys.* **50**, 445002 (2017). / A. Kaidatzis, G.

Giannopoulos, G. Varvaro, G. Dimitrakopoulos, et al.

14. **3-D Strain Fields in Low-Dimensional III-V Semiconductors: A Combined Finite Elements and HRTEM Approach** / *Phys. Status Solidi (a)* **215**, 1700409 (2018). / N. Florini, G. P. Dimitrakopoulos, et al.
15. **Compositional and strain analysis of In(Ga)N/GaN short period superlattices** (*Highlight paper*) / *J. Appl. Phys.* **123**, 024304 (2018). / G. P. Dimitrakopoulos, et al.
16. **Stabilization of Cr-rich tannery waste in fly ash matrices** / *Waste Management & Research* **36**, 818-826 (2018). / A. Daniil, G.P. Dimitrakopoulos, et al.
17. **Evolution of stratification in high-alloy content InGaN epilayers grown on (0001)AlN** / *Mater. Sci. & Tech.* **34**, 1565-1574 (2018). / G.P. Dimitrakopoulos, et al.